

中華民國專利證書

發明第 I 425596 號

發明名稱：具雙層陷阱之記憶體結構及其形成方法

專利權人：國立台灣大學

發明人：江榮進、胡振國

專利權期間：自 2014 年 2 月 1 日至 2031 年 7 月 7 日止

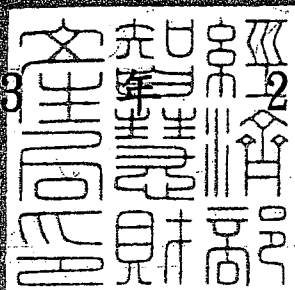
上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長 王美花

中華民國

103



月 1 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利